Vol. 18, No. 9 Sep., 2002

硅甲基接枝改性 MCM-48 的结构特征及表面性质

杨 佳 何 静 段 雪* Evans D.G. (北京化工大学可控化学反应科学与技术基础教育部重点实验室,北京 100029)

本文利用三甲基氯硅烷与未焙烧 MCM-48 反应, 实现对 MCM-48 的表面硅甲基接枝改性。结果表明: 原未焙烧 MCM-48 孔 道内的 CTAB 模板剂被脱除, 三甲基氯硅烷与表面羟基反应, 将硅甲基官能团接枝到 MCM-48 的内外表面。改性后 MCM-48 具 有良好的长程有序结构, 较窄的孔径分布, 较大的孔体积和较高的比表面积, 相对于未焙烧 MCM-48, 硅甲基接枝改性 MCM-48 的表面亲水性降低, 亲油性得到提高。

关键词:	MCM-48	表面硅甲基接枝改性	表面亲水/亲油性
分类号:	0613.72		

无机 - 有机纳米复合材料[1-20]由于兼具了有机 相态的弹性、韧性、可塑性和无机相态的高强度、耐 磨性、抗蠕变、耐高温等特点而受到广泛重视。常见 的无机 - 有机纳米复合材料制备方法是利用纳米级 的无机颗粒与聚合物材料复合, 但由于纳米颗粒具 有大的表面能.容易聚集.往往引起无机相分散不均 匀,同时,无机相与有机相的表面亲和性较差,界面 作用及相容性不理想。针对这种情况,我们提出了 无机 - 有机纳米网络粒子的设想 [21],利用介孔材料 可调变的纳米孔道结构、以及孔道尺寸和表面性质 可调变[22-26]的特点,将聚合物有机相引入介孔材料 的纳米孔道内, 形成无机 - 有机纳米网络粒子。其 中,无机相为介孔材料的纳米级孔壁,有机相为纳米 孔道内的聚合物、利用这种纳米网络粒子代替整体 无机相的填充材料、与聚合物基体复合,可制备全新 结构的复合材料,即纳米网络复合材料,并可能对原 有机材料的各项机械性能产生积极的影响。

MCM-48 分子筛具有满足最小表面拓扑结构的 三维螺旋面纳米孔道结构、良好的长程周期性和稳 定的骨架结构,其孔壁厚度约 1nm,孔道大小可在 1.5~3nm 范围内进行调变,因此本工作将其作为无 机-有机纳米网络结构的无机基体。但由于焙烧 MCM-48 的表面性质与聚合物性质上的差异可能不 利于孔道内有机相的引入,本文借鉴文献报道的对

> 收稿日期:2002-03-28。收修改稿日期:2002-05-27。 国家自然科学基金资助项目(No.59973004)。

*通讯联系人。E-mail: duanx@ buct. edu. cn

MCM-41 的改性方法^[22], 以三甲基氯硅烷作为官能 化试剂, 对未焙烧 MCM-48 进行硅甲基接枝改性, 期 望在除去孔道内模板剂的同时, 将甲基官能团引入 MCM-48 的内外表面, 使 MCM-48 获得开放的亲油 孔道。利用所得亲油孔道与有机材料的亲和性, 将聚 合物顺利引入无机材料的孔道内, 实现无机 - 有机 纳米网络粒子结构。

1 实验部分

1.1 MCM-48 的合成

以水热合成法制备 MCM-48。反应物配比为 1SiO₂: 0. 21NaO₂: 0. 65CTAB: 62H₂O。将一定量的 CTAB 在磁力搅拌下, 40℃左右, 用去离子水充分溶 解。滴人正硅酸乙酯, 搅拌均匀后滴人质量分数为 4%~5%的 NaOH 溶液, 使成澄清均相液体, 当溶液 突变为乳白色后继续搅拌 1~2min, 然后于高压反 应釜内 98℃晶化 5 天, 过滤, 并用 500mL 左右去离 子水洗涤, 滤饼烘干后得未焙烧 MCM-48 原粉。

1.2 硅甲基接枝改性 MCM-48 的制备

称取 1.5g 未焙烧 MCM-48 样品,加入 54mL 三 甲基氯硅烷 (TMCS),于 40~45℃ 分别回流反应 12h、24h、36h 后,加入 27mL 吡啶继续反应 18h(分 别对应 12h+18h、24h+18h、36h+18h 样品),TMCS 与吡啶同时加入未焙烧 MCM-48(即 TMCS 与未焙

第一作者:杨 佳,女,25岁,硕士研究生;研究方向:无机-有机纳米网络粒子的制备、表征及性能研究。

烧 MCM-48 的单独反应时间为 0h) 混合反应 18h 制 备 0h + 18h 样品。然后将所得悬浮液先后用正已烷 和大量无水乙醇过滤洗涤以除去硅甲基接枝改性 MCM-48 以外的反应产物和过量 TMCS,于通风橱内 自然干燥得白色粉末,最后在真空干燥器内,95℃下 干燥 2~3h 即得硅甲基接枝改性 MCM-48。

1.3 硅甲基接枝改性 MCM-48 的表征

硅甲基接枝改性 MCM-48 的晶态结构通过 XRD 表征,采用日本岛津 XRD-6000 型 X-射线衍射 仪, Cu Kα 光源,电压 40kV,电流 30mA,连续扫描, 扫描速度 1°・min^{~1},扫描范围 1°到 10°。

甲基接枝改性 MCM-48 的骨架成分以 FT-IR 红 外光谱表征, VECTER 22 傅立叶变换红外光谱仪 (德国布鲁克公司),扫描速度 20 次/秒,样品以 KBr 压片。

硅甲基接枝改性 MCM-48 的热分解行为用 TG、 DTA 表征, PCT-IA 型差热天平(北京光学仪器厂), 升温速度 10℃・min⁻¹,温度范围室温至 600℃,热 重量程 10mg,差热量程 ±100μV。

硅甲基接枝改性 MCM-48 的比表面积及孔径分 布由低温氮吸 - 脱附表征,由吸附曲线以 BET 方法 计算比表面积,由脱附曲线通过 BJH 模型计算孔 径。吸附温度为液氮温度 77K。表面亲水/亲油性由 水蒸气和异丙醇蒸汽吸 - 脱附表征,蒸汽产生温度 323K,硅甲基接枝改性样品水蒸气吸附温度为 283K,异丙醇蒸汽吸附温度为 289K;焙烧 MCM-48 样品水蒸气吸附温度为 288K,异丙醇蒸汽吸附温度 为 289K。AS-1C-VP 型比表面 - 孔径分布测定仪(美 国康塔公司),He 为载气,样品在测量前进行脱气处 理,脱气温度 110℃,脱气时间 2h。

硅甲基接枝改性 MCM-48 的孔道结构用 TEM 观察, J1M-2010 型透射电镜仪, 样品用无水乙醇分散。

为分析硅甲基接枝改性 MCM-48 各样品中的有 机成分,并确定原未焙烧 MCM-48 孔道内的 CTAB 是否充分脱除,对硅甲基接枝改性 MCM-48 样品进 行了有机元素分析,意大利 CARLO ERBA 1106 型 元素分析仪,元素重量百分比检测下限 0.3%。

2 结果与讨论

2.1 硅甲基接枝改性 MCM-48 的表面结构

图 1 为焙烧前 MCM-48 和焙烧后 MCM-48 的



Fig. 1 FT-IR spectra of calcined and uncalcined MCM-48

红外谱图。3440cm⁻¹ 附近的宽吸收峰归属为 ≡ Si(OH)、=Si(OH)₂ 或 -Si(OH)₃等表面羟基的吸 收峰,未焙烧 MCM-48 在 1217cm⁻¹ 附近的强吸收峰 归属为 -CH₃ 的伸缩振动,在 2854cm⁻¹和 2923cm⁻¹ 出现的窄吸收峰归属为 -CH₂- 的特征吸收峰,其中 -CH₃ 在 2960cm⁻¹ 附近的吸收峰被 -CH₂- 在 2923 cm⁻¹的强吸收峰掩盖,1371cm⁻¹和 1485cm⁻¹的双 峰归属为 -CH₂- 的面内弯曲振动,1054cm⁻¹处的吸 收峰归属为硅氧四面体的反对称伸缩振动。965 cm⁻¹和 914cm⁻¹的两个肩峰被认为是表面活性剂 的 C-C 及 C-N 键伸缩振动引起的,458cm⁻¹ 附近的 吸收峰归属为硅氧键的弯曲振动。焙烧 MCM-48 的 红外特征吸收峰与无定形二氧化硅的特征吸收峰相 似,表明 MCM-48 的次级结构为无定形,与文献^[54] 报道结果一致。

由硅甲基接枝改性 MCM-48 的红外谱图 (图 2) 可知:未焙烧 MCM-48 中由 CTAB 引入的 -CH₂- 特征 吸收峰: 2854cm⁻¹ 附近的单峰、2923cm⁻¹ 附近的单 峰和 1371cm⁻¹ 与 1485cm⁻¹ 的双峰,在改性样品中 没有出现。未焙烧 MCM-48 中的 CTAB 在 965cm⁻¹ 和 914cm⁻¹ 附近的 C-C 键伸缩振动和 C-N 键伸缩振 动峰在硅甲基接枝改性后消失。这说明硅甲基接枝 改性后,原未焙烧 MCM-48 孔内模板剂 CTAB 被脱 除。3440cm⁻¹ 附近的表面羟基吸收峰强度减弱,峰

• 881 •



形变窄,即原 MCM-48 的表面羟基含量减小,但没有 完全消失,这一方面说明 MCM-48 的表面羟基已被 -Si-(Me) 3 基团接枝,另一方面,由于空间位阻效应, 当 MCM-48 表面某 -OH 被取代形成 -O-Si-(Me) 3 后, 邻近的羟基不能与其他三甲基氯硅烷分子发生反 应,从而影响了羟基的利用率。与未焙烧 MCM-48 的 -CH3 特征吸收峰相比,由于甲基键合环境发 生变 化,由 CTAB 的 -N-(Me) 3 变为硅甲基接枝改性 MCM-48 的 -Si-(Me) 3, -CH3 伸缩振动吸收峰由焙烧 前的 1217cm⁻¹ 红移至硅甲基接枝改性后的 1250 cm⁻¹,从原肩峰中分离出来。接枝改性后 2960cm⁻¹ 附近的 -CH3 特征吸收峰十分明显。红外谱图表明, 未焙烧 MCM-48 孔道内的 CTAB 模板剂脱除,同时 甲基官能团通过三甲基氯硅烷与表面羟基键合,被 引入 MCM-48 的无机骨架表面。从红外谱图来看, 24h + 18h、36h + 18h 硅甲基接枝改性 MCM-48 的甲 基特征吸收峰较明显,说明二者可能具有较好的硅 甲基接枝改性效果。

为进一步考察硅甲基接枝改性后 MCM-48 孔道 内有机成分的含量,分别对 0h+18h、12h+18h、 24h + 18h、36h + 18h 硅甲基接枝改性 MCM-48 做了 有机元素分析。表1显示, 硅甲基接枝改性样品中 C、H 元素重量百分比含量相对于未焙烧 MCM-48 有 明显降低, 说明原未焙烧 MCM-48 孔道内的 CTAB 模板剂大部分被脱除,但由于四个改性样中的 N 元 素含量均小于仪器检测下限 0.3%, 因此 CTAB 是 否脱除完全从 N 元素百分含量数据不好判断, 需进 一步采用其它方法如热分析进行表征。从表1中C、 H 元素百分比含量的变化规律可以看出, 前三个样 品的有机含量依次减小,这显示了改性过程中模板 剂的逐步脱除过程。36h+18h 硅甲基接枝改性 MCM-48 的 C、H 元素含量较高, 这是由于该样品改 性时间较长,三甲基氯硅烷与表面羟基充分反应,产 物表面甲基含量较高引起的。

硅甲基接枝改性样品的 DTA 曲线示于图 3。与 未焙烧 MCM-48 的 DTA 曲线相比, 硅甲基接枝改性 样品中模板剂的燃烧峰消失,显示 CTAB 大部分被 脱除。0h + 18h、12h + 18h、24h + 18h 硅甲基接枝改 性 MCM-48 样品的 DTA 曲线显示了两种热分解过 程,这表明反应过程中除了模板剂的逐步脱除、硅甲 基官能团的引入外,可能还有其它化学键的形成,即 中间接枝形态的存在,反应不完全。甲基基团的化学 键结构单一,热分解温度范围窄,峰形相对尖锐,而 36h + 18h 硅甲基接枝改性样品的 DTA 放热峰为尖

表 1 硅甲基接枝改性 MCM-48 的有机元素分析

Table 1 Organic Element Contents of Sulfated MCM-46					
element%	uncalcined MCM-48	0h + 18h silylated MCM-48	12h + 18h silylated MCM-48	24h + 18h silylated MCM-48	36h + 18h silylated MCM-48
N%	1.99				_
С%	39.17	15.50	14.41	13.69	17.21
H%	7.56	3.98	3.74	3. 65	4. 18

不明显。从热失重率(表 2)可以看出,相对于未焙烧 MCM-48,改性样品的失重率较低,模板剂在一定程 度上被脱除。0h + 18h、12h + 18h和 24h + 18h改性 样品的失重率依次减小,表明原未焙烧 MCM-48 孔 道内的模板剂逐步被脱除。36h + 18h样品的失重率 稍大于其它反应条件下所得样品的失重率,这是由 反应充分、更多的硅甲基官能团被引入、有机成分增 加引起的。以上变化趋势与有机元素分析结果— 致。

2.2 硅甲基接枝改性 MCM-48 的孔结构

图 4 为 36h + 18h 硅甲基接枝改性 MCM-48 的 低温氮吸 - 脱附等温线和孔径分布图,为了便于对 比,图 5 示出了焙烧 MCM-48 的吸 - 脱附等温线和 孔径分布图。硅甲基接枝改性 MCM-48 和焙烧 MCM-48 的等温线形状相似,为典型的 IV 型等温线, 表明硅甲基接枝改性 MCM-48 仍具有介孔结构。从



图 4 36h + 18h 硅甲基接枝改性 MCM-48 的低温 N₂ 吸-脱附等温线及孔径分布图

Fig. 4 N₂ adsorption-desorption isotherm and pore size distribution of silylated MCM-48
Note: Volume: adsorbed volume of nitrogen on the surface of 36h + 18h silylated MCM-48
p: actual gas pressure of nitrogen
p₀: saturated gas pressure of nitrogen at 77K



图 3 硅甲基接枝改性 MCM-48 的 TG 和 DTA 曲线

- Fig. 3 TG and DTA plots of silylated MCM-48
 - (a) uncalcined MCM-48
 - (b) 0h + 18h silylated MCM-48
 - (c) 12h + 18h silylated MCM-48
 - (d) 24h + 18h silylated MCM-48
 - (e) 36h + 18h silylated MCM-48

锐单峰,可归属为甲基燃烧峰,这表明这一条件下硅 甲基接枝改性反应进行得较充分。

从 TG 曲线可以看出, 与未焙烧 MCM-48 相比, 硅甲基接枝改性 MCM-48 内有机相含量较少, 失重

佳等: 硅甲基接枝改性 MCM-48 的结构特征及表面性质 杨

表 2 硅甲基接枝改性 MCM-48 的热失重率 Table 2 TG Results of Silvlated MCM-48 uncalcined 0h + 18h 12h + 18h24h + 18h 36h + 18h MCM-48 silylated MCM-48 silylated MCM-48 silvlated MCM-48 silylated MCM-48 weight loss /% (200 ~ 500°C) 52.15 12.28 11.09 9.36 12.62 25Å。低温 N2 吸 - 脱附及孔径分析结果充分证明硅 730. 633 5 563.1 寸孔道、大的比表面积和高的介孔孔体积。 492.7 2.3 硅甲基接枝改性 MCM-48 的长程结构 422.3 351,9 281 5 211.1 140.7 70.39 0.00 04187 0.5234 0.6280 0.7327 0.8374 0.9420 1.0467 0.1047 0.2093 0.3140 HCl 在无水环境下没有破坏 MCM-48 的骨架结构。 BJH desorption Dv(d) 0.306 0.275 **** 0.2450 0.2144 £ 孔壁结构([111]晶面)。 ġ 0 183 (P)VQ 0.153 0.122 물 0.09 cbs 0.061 0.030 0.000 1000 100 18-0

焙烧 MCM-48 的低温 № 吸 - 脱附等温线及孔径 图 5 分布

Fig. 5 N2 adsorption-desorption isotherm and pore size distibution of calcined MCM-48 Note: Volume: adsorbed volume of nitrogen on the surface of calcined MCM-48 p: actual gas pressure of nitrogen

po: saturated gas pressure of nitrogen at 77K

36h + 18h 硅甲基接枝改性 MCM-48 的孔径分布图 可以看出, 36h + 18h 硅甲基接枝改性 MCM-48 具有 较窄的孔径分布。表3列出了硅甲基接枝改性 MCM-48 和焙烧 MCM-48 的孔体积和比表面积数 据。从表 3 数据可以看出, 硅甲基接枝改性 MCM-48 的介孔孔体积、总孔体积和比表面积相对于焙烧 MCM-48 都略有降低, 二者最可几孔径接近, 均为 甲基接枝改性 MCM-48 具有 MCM-48 特征的纳米尺

图 6 为硅甲基接枝改性 24h + 18h、36h + 18h 的 MCM-48 的 XRD 谱图,为了对比,同时列出了焙烧 MCM-48 的 XRD 谱图。从图中可以看出, 硅甲基接 枝改性 MCM-48 保持了原 MCM-48 的特征衍射峰, 三甲基氯硅烷与 MCM-48 表面羟基反应所产生的

由高分辨 TEM 照片(图7)可以明显观察到硅 甲基接枝改性 MCM-48 具有规则的纳米尺寸孔道和





- (A) 24h + 18h silvlated MCM-48
- (B) 36h + 18h silvlated MCM-48
- (C) calcined MCM-48

	NGC 1 CE					
Table 3	Pore Vo	lume and	I Surface	Area	of Silylate	d MCM-48

共用其按共改性 MCM.48 的习体积和比赛面积

samples to	tal pore volume / $(cc \cdot g^{-1})$	mesopore volume/(cc · g ⁻¹)	surface area/ $(m^2 \cdot g^{-1})$	pore diameter/(Å)
calcined MCM-48	1. 2850	0.6262	1203	25
silvlated MCM-48	0. 9592	0. 5393	1172	25

• 884 •



图 7 硅甲基接枝改性 MCM-48 的 TEM 照片 Fig. 7 TEM micrograph of 36h + 18h silylated MCM-48

2.4 硅甲基接枝改性 MCM-48 的表面性质

图 8 为硅甲基接枝改性 MCM-48 和焙烧 MCM-48 的水蒸气吸 - 脱附等温线。二者的吸附曲 线均为Ⅳ型等温线、脱附曲线与吸附曲线之间存在 明显的滞后环。由焙烧 MCM-48 的水蒸气吸-脱附 等温线可以看出,由于焙烧 MCM-48 表面羟基具有 亲水性,吸附水蒸气在单纯减小相对蒸汽压(横坐 标)的情况下,无法完全脱除,脱附曲线与吸附曲线 无法重合,因此滞后环未闭合,呈现出表面亲水性的 特征滞后环,这时脱附曲线与吸附曲线的吸附量(纵 坐标)差值只有通过升高温度才能完全消除。硅甲 基接枝改性 MCM-48 的水蒸气吸 - 脱附曲线滞后环 闭合,减小相对蒸汽压,水蒸气能从其表面上完全脱 除,即相对于焙烧 MCM-48,水与硅甲基接枝改性 MCM-48 表面的亲和性下降。如表 4 所示, 焙烧 MCM-48 对水的最大吸附量远大于硅甲基接枝改性 MCM-48, 说明硅甲基接枝改性使 MCM-48 的表面亲 水性大大降低。

从硅甲基接枝改性 MCM-48 和焙烧 MCM-48 的 异丙醇蒸汽吸-脱附等温线(示于图9)可以看出,焙 烧 MCM-48 的滞后环从水蒸气吸-脱附等温线的开 环转变为异丙醇蒸汽吸-脱附等温线的闭环,表明 异丙醇与焙烧 MCM-48 的亲和性低于水与焙烧



- 图 8 硅甲基接枝改性 MCM-48(A)和焙烧 MCM-48(B)的 水蒸气吸-脱附等温线
- Fig. 8 Water vapor adsorption-desorption isotherm of 36h + 18h silylated MCM-48 (A) and calcined MCM-48 (B)
 Note: Volume: adsorbed volume of water vapor on the surface of 36h + 18h silylated MCM-48 (A) and calcined MCM-48 (B)
 p: actual water vapor pressure
 p₀: saturated water vapor pressure at 283K(A) and 288K(B)

MCM-48 的亲和性,可从其表面上完全脱除。表4显示, 硅甲基接枝改性 MCM-48 对异丙醇的吸附量大于对水的吸附量, 而焙烧 MCM-48 对异丙醇的吸附量小于对水的吸附量。由于异丙醇的极性小于水的极性,因此,以上变化趋势表明,硅甲基接枝改性大大提高了 MCM-48 的表面亲油性。

3 结 论

(1) 红外和有机元素分析以及热分析的结果表明,原未焙烧 MCM-48 孔内的模板剂 CTAB 可被脱除,同时,三甲基氯硅烷与表面羟基反应,硅甲基官能团被接枝到 MCM-48 的内外表面。

表 4 水蒸气与异丙醇蒸汽的吸附量 Table 4 Adsorbed Volumes of Water and Isopropanol Vapors

	surface area maximal volume of adsorbed water vapor			maximal volume of adsorbed isopropanol vapor			
adsorbents	$/(m^2 \cdot g^{-1})$	/(cc · g ⁻¹)	/(cc • m ⁻²)	/(cc · g ⁻¹)	/(cc · m ⁻²)		
calcined MCM-48	1203	1301	1.08	321	0. 267		
36h + 18h silylated MCM-48	1172	25.7	2. 19×10^{-2}	251	0. 214		







Fig. 9 Isopropanol vapor adsorption-desorption isotherm of 36h + 18h silylated MCM-48 (A) and calcined MCM-48 (B)

> Note: Volume: adsorbed volume of water vapor on the surface of 36h + 18h silylated MCM-48 (A) and calcined MCM-48 (B)

p: actual water vapor pressure

 p_0 : saturated water vapor pressure at 289K(A and B)

(2) XRD、TEM 和低温氮吸 - 脱附实验结果表明, 硅甲基接枝改性 MCM-48 保持了原 MCM-48 的 长程有序结构,并具有分布较窄的孔径、较高的介孔 体积和大的比表面积。

(3) 水蒸气吸 - 脱附实验和异丙醇吸 - 脱附实验结果表明, 相对于焙烧 MCM-48, 硅甲基接枝改性 MCM-48 的表面亲水性大大降低, 表面亲油性得到提高。

参考文献

- [1] Wen Jianye, Wilkes G. L. Chem. Mater., 1996, 8, 1667.
- [2] Novak M. B. Adv. Mater., 1993, 5(6), 422.
- [3] Matsuyama Hiroyoshi, Young F. J. J. Mater. Res., 14(8), 3389.
- [4] Curliss B. D. Polymn. Prepr., 2000, 41(1), 523.

- [5] Mountz A. D., Reuschle A. D., Storey F. R., Mauritz A. K. Polymn. Prepr., 1999, 40 (2), 892.
- [6] Dietsche F., Thomann Y., Thomann R., Mülhaupt R. Journal of Applied Polymer Science, 2000, 75, 396.
- [7] Dietsche F., Mülhaupt R. Polymer Bulletin, 1999, 43, 395.
- [8] Lee J. Y., Baljon R. C. A., Loring F. R. J. of Chem. Phys., 1999, 111(21), 9754.
- [9] Huang Xingyu, Lewis S., Brittain J. W., Vaia A. R. Polymer Preprints, 2000, 41(1), 589.
- [10]Krishnamoorti R., Vaia A. R., Giannelis P. E. Chem. Mater., 1996, 8, 1728.
- [11] Giannelis P. E. Adv. Mater., 1996, 8(1), 29.
- [12] Giannelis E. P., Chen H., Demeter J., Manias E. Polym. Prepr., 1999, 40(2), 91.
- [13]Shi Hengzhen, Lan Tie, Pinnavaia T. J. Chem. Mater., 1996, 8, 1584.
- [14] CN 1187506A
- [15] Heinemann J., Reichert P., Thomann R., Mülhaupt R. Polym. Prepr., 1999, 40(2), 788.
- [16] Frisch H. L., Maaref S., Xue Y., Beaucage G., Pu Z., Mark J. E. J. of Polym. Sci. : Part A: Polymer Chemistry, 1996, 34, 673.
- [17] Frisch L. H., Mark E. J. Chem. Mater., 1996, 8, 1735.
- [18] O'Brien S., Tudor J., Maschmeyer T., O'Hare D. Chem. Commun., 1997, 1905.
- [19] Moller K., Bein T., Fischer X. R. Chem. Mater., 1999, 11, 665.
- [20] Wu Chun-Guey, Bein T. Science, 1994, 264, 1757.
- [21] He Jing, Duan Xue, Evans D. G. J. Porous Mater., 2002, 9, 49.
- [22] Antochshuk V., Jaroniec M. Chem. Commun., 1999, 2373.
- [23] Dai Sheng, Shin Yongsoon, Burleigh M. C., Lin Jar-Shyong, Barnes C. E., Xue Ziling Adv. Mater., 1999, 11 (14), 1226.
- [24] Macquarrie J. D., Jackson B. D., Mdoe E. G. J., Clark H. J. New J. Chem., 1999, 23, 539.
- [25] Ryoo R., Jun S., Kim J. M., Kim M. J. Chem. Commun., 1997, 2225.
- [26] Liu Chun-Jing, Li Shou-Gui, Pan Wen-Qin, Che Chi-Ming Chem. Commun., 1997, 65.
- [27]CAI Qiang(蔡 强), WEI Chang-Ping(魏长平), XU Yong -Yi(许永宜), PANG Wen-Qin(庞文琴), ZENG Kai-Ji (甑开吉) Gaodeng Xuexiao Huaxue Xuebao(Chemical Journal of Chinese Universities), 1999, 20, 344.

第 18 卷

Structure and Surface Properties of Silylated MCM-48

YANG Jia HE Jing DUAN Xue* Evans D. G.

(Key Laboratory of Science and Technology of Controllable Chemical Reactions, Ministry of Education, Beijing University of Chemical Technology, Beijing 100029)

Trimethylsilyl grafted MCM-48 was prepared using TMCS (trimethylcholorosilane) and uncalcined MCM-48. The results suggest that CTAB (cetyl trimethyl ammonium bromide) can be extracted from the channels of MCM-48, and TMCS can react with hydroxyl groups on the surface of MCM-48, making the three dimensional mesopores of MCM-48 open and accessible to the polymer. Trimethylsilyl groups are anchored on the surface of MCM-48, and the resulted silylated MCM-48 material has long range ordered structure, narrow pore-size distribution, high surface area and large mesopore volume. Compared with calcined MCM-48, the organophilic property of silylated MCM-48 is enhanced, and its hydrophilic property is decreased.

Keywords: MCM-48 silylation surface organophilic/hydrophilic property